

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE

Patent Number: JP59208756
 Publication date: 1984-11-27
 Inventor(s): AKIYAMA KATSUHIKO; others: 02
 Applicant(s):: SONY KK
 Requested Patent: ☐ JP59208756
 Application JP19830083188 19830512
 Priority Number(s):
 IPC Classification: H01L23/12 ; H01L21/56 ; H01L23/48
 EC Classification:
 Equivalents: JP1760995C, JP4047977B

Abstract

PURPOSE: To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.

CONSTITUTION: Au plating 12 of 1μm thickness, Ni plating 13 of 1μm thickness and Au plating 14 of 3μm are laminated on an Fe substrate 11 of 35μm thickness. A semiconductor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm.. The Fe substrate is removed by etching with FeCl3 solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In order to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—208756

⑪ Int. Cl.³

H 01 L 23/12
21/56
23/48

識別記号

庁内整理番号

7357—5F
7738—5F
7357—5F

⑬ 公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑭ 半導体装置のパッケージの製造方法

① 特 願 昭58—83188

② 出 願 昭58(1983)5月12日

⑦ 発 明 者 秋山克彦
東京都品川区北品川6丁目7番
35号ソニー株式会社内

⑧ 発 明 者 小野鉄雄
東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

⑨ 発 明 者 梶山雄次
東京都品川区北品川6丁目7番
35号ソニー株式会社内

⑩ 出 願 人 ソニー株式会社
東京都品川区北品川6丁目7番
35号

⑪ 代 理 人 弁理士 土屋勝 外2名

明 細 書

1. 発明の名称

半導体装置のパッケージの製造方法

2. 特許請求の範囲

選択ニッテング可能な材料から成る基板上に半導体装置を配置し、接続用ワイヤを上記半導体装置に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部電極部を上記基板の外部電極接続部位に接続し、次いで上記基板上において上記半導体装置及び上記接続用ワイヤを一体に樹脂モールドし、しかる後上記基板をエッチング除去することを特徴とする半導体装置のパッケージの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、半導体装置のパッケージの製造方法に関する。

背景技術とその問題点

従来、プリント基板上の実装密度の高いパッケージとして、チップキャリアタイプのパッケージが知られている。このパッケージはリードレス

タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き出されているハンダ付け可能な電極をプリント基板上の導体パッドに直接ハンダ付けして接続することにより実装を行うものである。

このチップキャリアタイプパッケージには、セラミックタイプとプラスチックタイプとがある。セラミックタイプはパッケージ自体が高価であるばかりでなく、プリント基板上に直接ハンダ付けすると、温度サイクル時にセラミックと上記ハンダ及び上記導体との間の熱膨張係数の差によつて接続部にはがれやクラックが生じる恐れがあるという欠点を有している。一方、プラスチックタイプはパッケージが安価であるという利点を有しているが、熱放散性が悪く、また形状がパッケージの製造の自動化に適していないという欠点を有している。

このような従来のプラスチックタイプのチップキャリアタイプパッケージの構造を第1図に示す。このパッケージ(1)は、銅箔製の電極(2)が予め形成されているプリント基板(3)上に半導体装置を構成

するチップ(4)を載置し、ワイヤボンディング法により上記チップ(4)と上記電極(2)の一端とをAuの細線から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より液状のエポキシ樹脂を滴下させて硬化成形することによつて作る。

このパッケージ(1)において、チップ(4)は樹脂層(6)とプリント基板(3)とによつて囲まれている。これらの樹脂層(6)及びプリント基板(3)の熱抵抗は共に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に放散することができない。即ち、このパッケージ(1)は放散性が悪いという欠点を有している。また上記の液状のエポキシ樹脂を滴下する際に、微量の樹脂を一定量、しかも高速で滴下することが難しく、このためにパッケージ(1)はパッケージの製造の自動化に適していないという欠点を有している。

一方、上述のチップキャリアタイプパッケージとは異なるパッケージにテープキャリアタイプパッケージがある。このタイプのパッケージは従来のチップキャリアタイプパッケージよりもさらに

ることができる。なお上記外部電極部は上記接続用ワイヤ自体が兼ねていてもよいし、上記接続用ワイヤとは別に設けられかつ上記接続用ワイヤが接続されているものでもよい。

実施例

以下本発明に係る半導体装置のパッケージの製造方法の実施例につき図面を参照しながら説明する。

第2A図～第2D図は本発明の第1実施例による半導体装置のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2A図から工程順に説明する。

まず第2A図において、厚さ35(μ)のFe製の基板10の上に、厚さ1(μ)のAu層12、厚さ1(μ)のNi層13及び厚さ3(μ)のAu層14を順次メッキして、半導体装置を形成するチップ15の載置部16及び外部電極部17のそれぞれを上記基板10の所定のチップ載置部位(11g)及び外部電極接続部位(11h)(11i)のそれぞれに設ける。第2A図に示す工程終了後の上記基板10の平面図を第

3図に示す。次に第2B図において、上記チップ載置部16にチップ15を載置した後、ワイヤボンディング法によつてこのチップ15と上記外部電極部17とをそれぞれAuの細線から成るワイヤ18で接続する。次に第2C図において、第2B図の基板10の上に設けられた上記外部電極部17、チップ載置部16、チップ15及びワイヤ18を一体とするために、公知のトランスファ・モールド法(移送成形法)を用いて、エポキシから成る樹脂モールド層19を上記基板10上に形成する。なお本実施例においては、上記樹脂モールド層19の厚さtを1

発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、熱放散性が良好でかつ信頼性の高い半導体装置のパッケージの製造方法を提供することを目的とする。

発明の概要

本発明に係る半導体装置のパッケージの製造方法は、選択エッチング可能な材料から成る基板上に半導体装置を載置し、接続用ワイヤを上記半導体装置に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部電極部を上記基板の外部電極接続部位に接続し、次いで上記基板上において上記半導体装置及び上記接続用ワイヤを一体に樹脂モールドし、しかる後上記基板をエッチング除去するようにしている。このようにすることによつて、熱放散性が良好でかつ信頼性の高いリードレスタイプのパッケージを、簡便かつ安価な方法によつて自動的に製造す

る。次に第2B図において、上記チップ載置部16にチップ15を載置した後、ワイヤボンディング法によつてこのチップ15と上記外部電極部17とをそれぞれAuの細線から成るワイヤ18で接続する。次に第2C図において、第2B図の基板10の上に設けられた上記外部電極部17、チップ載置部16、チップ15及びワイヤ18を一体とするために、公知のトランスファ・モールド法(移送成形法)を用いて、エポキシから成る樹脂モールド層19を上記基板10上に形成する。なお本実施例においては、上記樹脂モールド層19の厚さtを1

(μ)とした。

次に第2C図において、Feのみを選択的にエッチングするが樹脂モールド層19及びAu層12はエッチングしないエッチング液、例えば塩化第二鉄($FeCl_2$)溶液を用いて、基板10の裏面(11a)側からスプレーエッチングすることにより、上記基板10を除去して、第2D図に示すリードレスタイプのパッケージ20を完成させる。上記エッチングによつて露出されたAu層12の下面のうち外部

電極部0708のAu層02の下面が外部電極面(12b)(12c)となり、またチップ設置部09のAu層02の下面が熱放散面(12a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージ00をプリント基板上に実装する場合には、第2D図に示す上記外部電極面(12b)(12c)をプリント基板上の導体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述の第1実施例の熱放散面(12a)は、その動作時においてチップ09から発生する熱の放散面となつてゐる。金属の熱伝導度は非常に高いので、チップ09から発生する熱は金属製のチップ設置部09を外方に向かって迅速に流れて、熱放散面(12a)から放散されることによつて効果的に除去される。しかし、より効果的にチップ09の発生熱を除去するためには、広い表面積を有する放熱フィンの一部を上記熱放散面(12a)に押し当てて空冷により熱を放散させるのが好ましい。

上述の第1実施例のパッケージ00は第2A図～第2D図に示すような簡単な工程によつて作ること

が可能である。このように上記のエッチングによつてチップ設置部09及び外部電極部0708の下部に上記アンダーカット部(11a)～(11f)が形成されるので、これらの部分に樹脂が回り込んで突出部(20a)～(20f)が形成される。従つてこれらの突出部(20a)～(20f)によつて上記チップ設置部09及び上記外部電極部0708が下方から保持される構造となるので、上記チップ設置部09及び上記外部電極部0708がパッケージ00の使用時において樹脂モールド層04から抜け出てしまうのを防止することができるという利点がある。さらにチップ設置部09及び外部電極部0708が樹脂モールド層04の下面から突出することなく形成されるので、これらのチップ設置部09及び外部電極部0708を保護することができるという利点もある。

第5A図～第5C図は本発明の第2実施例による半導体装置のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第5A図から工程順に説明する。

まず第5A図において、厚さ35(μ)のCu

とができるばかりでなく、全ての製造工程に従来から用いられている装置を用いることができるので、テープキャリアタイプのパッケージにおいて必要な既述の特殊な装置が不要である。従つて、簡便かつ安価な方法によりパッケージ00を製造することができる。さらに上述の第1実施例では樹脂モールド層04を形成する方法としてトランスフア・モールド法(移送成形法)を用いている。この方法は信頼性の高い樹脂封止ができるばかりでなく、モールドの機械化、量産化が容易であるためにパッケージを自動的に製造できるという利点を有している。

なお上述の第1実施例において、第2A図に示す場合と同様にチップ設置部09及び外部電極部0708を設けた後に、基板01の上面を既述の $FeCl_3$ 溶液を用いて僅かにエッチングすることにより、第4A図に示すようにチップ設置部09及び外部電極部0708の下部の基板01にアンダーカット部(11a)～(11f)を形成し、次に第2B図～第2D図と同様な方法によつて第4B図に示すパッケージ00を

製の基板01の上面に公知のフォトリソストを塗布した後に所定のパターンニングを行う。次いでCuのみを選択的にエッチングするエッチング液、例えば既述の $FeCl_3$ 溶液を用いて上記基板01の表面を僅かにエッチングすることによつて、上記基板01の表面にチップ設置部位(11g)及び外部電極接続部位(11h)(11i)をそれぞれ形成する。上記フォトリソストを除去した後に第5B図において、第1実施例と同様に、上記チップ設置部位(11g)にハンダ層04を介してチップ09を設置した後、ワイヤボンディング法によつてこのチップ09と上記外部電極接続部位(11h)(11i)とをそれぞれAgの細線から成るワイヤ09で接続する。なお本実施例においては、既述の理由により、第1実施例で用いたワイヤよりも径の大きいワイヤを用いた。次に第1実施例と同様に樹脂モールド層04を上記基板01上に形成する。次に上記基板01を第1実施例と同様な方法でエッチング除去してパッケージ00を完成させる。上記エッチングにより露出されたワイヤ09の露部が外部電極部0708となり、またハ

ンダ層の下面が熱放散面(23a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージ4をプリント基板上に実装する場合には、第1実施例と同様に、図3C図に示す上記外部電極部10aをプリント基板上の導体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。このことから明らかなように、本実施例においてはワイヤ14の端部をそのまま外部電極部10aとして用いるために、ワイヤ14の径を前述のように大きくするのが好ましい。なお熱放散面(23a)の機能は第1実施例と同様である。

上述の第2実施例のパッケージ4は、第1実施例のパッケージ4と異なつて、フォトリソスト工程及びエッチング工程によつて基板10に設けられた外部電極接続部位(11b)(11i)にワイヤ14を直接接続するようにしているので、第1実施例のパッケージ4におけるAu層10a及びNi層10bを形成する必要がない。上記のフォトリソスト工程及びエッチング工程は第1実施例のパッケージ4で用いたメッキ工程よりもさらに簡便である。またこれらのフォトリソスト工程及びエッチング工程

を用いることにより、Au等の貴金属を用いる必要がなくなるという利点がある。

上述の第1実施例及び第2実施例においては、1個のチップをチップ設置部に設置してこれを樹脂モールドする場合につき述べたが、基板上に多数のチップ設置部を設け、それぞれのチップ設置部に同一のチップを設置して、これらのチップを一体に樹脂モールドした後に切断分離することにより、それぞれ1個のチップを有する同一のパッケージを多数個同時に作ることもできる。また各種のチップと、コンデンサや抵抗等の受動素子とを基板上に設置した後にこれらを一体に樹脂モールドすれば、種々の機能を有するパッケージを作ることができると共に、回路素子の集積度の高いパッケージを作ることができるという利点がある。

上述の第1実施例の基板の材料は選択エッチングが可能であればCu等の他の金属であつてもよく、また第2実施例の基板の材料もFe等の他の金属であつてもよい。第1実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系樹

脂を用いることも可能である。この場合には前述のエッチング液としては、ヒドラジンとエチレンジアミンとの混合液を用いればよい。

発明の効果

本発明に係る半導体装置のパッケージの製造方法によれば、その動作時において半導体装置から発生する熱の放散性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパッケージを、極めて簡便かつ安価な方法によつて自動的に製造することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来のプラスチックタイプのチップキャリアタイプパッケージの構造を示す断面図、第2A図～第2D図は本発明の第1実施例による半導体装置のパッケージの製造方法を説明するための工程図、第3図は上記第2A図に示す工程終了後の基板の平面図、第4A図及び第4B図は上記第1実施例の実施例を示す上記第2A図～第2D図と同様な図、第5A図～第5C図は本発明の第2実施例による半導体装置のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。

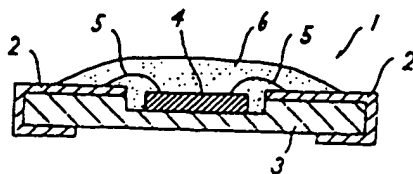
なお図面に用いた符号において、

(1)(2)(3)(4).....	パッケージ
(4)(5).....	チップ
(5)(6).....	ワイヤ
10.....	基板
(11b)(11i).....	外部電極接続部位
10a.....	外部電極部
20.....	樹脂モールド層

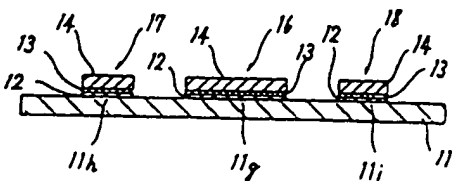
である。

代 理 人	土 屋 勝
	常 包 芳 男
	形 南 俊 賢

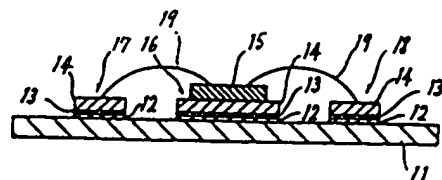
第 1 図



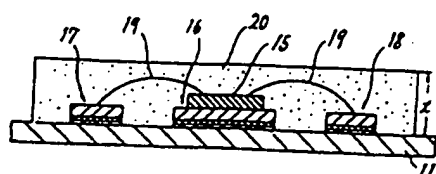
第 2 A 図



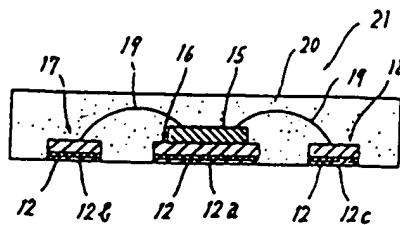
第 2 B 図



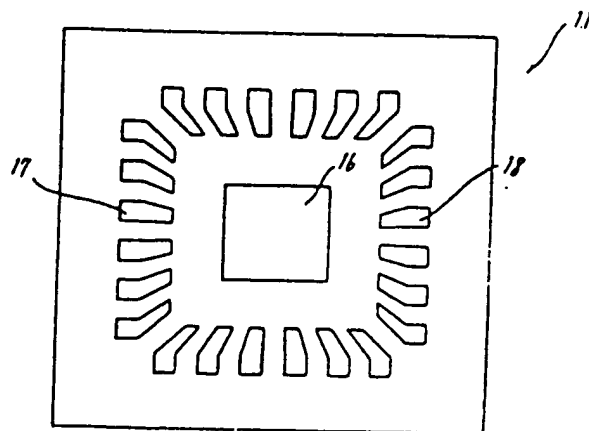
第 2 C 図



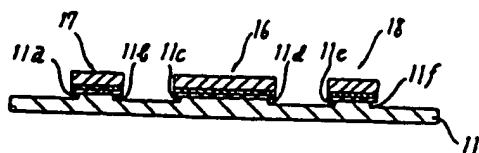
第 2 D 図



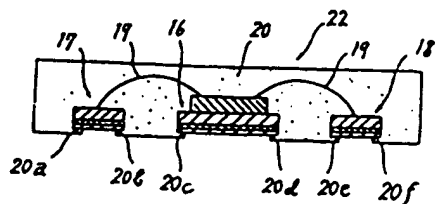
第 3 図



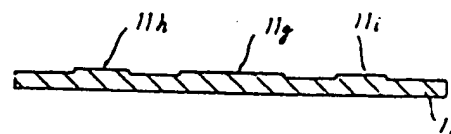
第 4 A 図



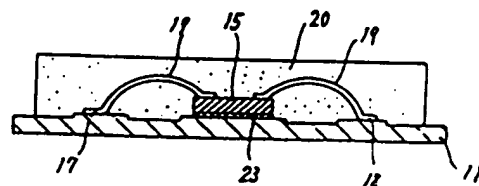
第 4 B 図



第 5 A 図



第 5 B 図



第 5 C 図

